Statischer Schreib-Lese-Speicher
Static random access memory

U 202 D Statischer 1 K Bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) in n-Kanal-Si-gate-Technologie
- Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten
- Adresseneingangsschaltung für 10 Adressen
- Spaltendecoder mit Ein- und Ausgabeschaltung
- Zeilendecoder
- Ein- und Ausgabesteuerung
- Schlafsteuerung
- 16poliges DIL-Gehäuse (2,5 mm Rastermaß, 7,5 mm Reihenabstand)

1-K bit (1024×1-bit) static random access memory in channel Silicon-gate-technology
- memory matrix consisting of 32 rows and 32 columns
- address iput circuitry for 10 addresses
- column dekoder with data infout circuitry
- row decoder
- inpout and outpout control
- standley power made
- standard 16-pin-DIP-package (scale distance 2,5 mm line distance 7,5 mm)

Grenzdaten (bezogen auf U_{SS}) max. ratings (related to U_{SS})		Betriebsbedingungen operating conditions		Informationsdaten characteristics	
U_G	= −0,5 ... +7 V	U_{CC}	= 4,75 ... 5,25 V	t_A	< 450 ns
ϑ_{stg}	= −65 ... 150 °C	U_{IL}	= −0,5 ... +0,8 V	t_{RC}	> 450 ns
		U_{IH}	= 2 V ... U_{CC}	t_{WC}	> 450 ns
		ϑ_a	= 0 ... +70 °C	U_{CC}	> 2 V

Dynamischer Schreib-Lese-Speicher
Dynamic random access memory

U 253 C Dynamischer 1024 bit-Schreib-Lese-Speicher (RAM) in p-Kanal-Si-gate-Technologie.
- Speichermatrix mit 32 Zeilen und 32 Spalten
- Adressenregister und Inverter für 10 Adressen
- Zeilendekoder mit Lese-/Schreib-Verstärkern
- Spaltendekoder mit Ein- und Ausgabeeinheit
- Refreshverstärker
- Zyklussteuerung
- 18poliges DIL-Gehäuse (2,5 mm Rastermaß, 7,5 mm Reihenabstand)

Dynamic 1024-bit random access memory in p-channel-silicon-gate-technology
- memory matrix with 32 rows and 32 columns
- address register and inverter for 10 addresses
- row decoder with read/write-amplifiers
- column decoder with input-and output-unit
- refresh amplifiers
- cycle control
- the circuit is supplied in a 18-pin-DIL-package (scale distance 2,5 mm, line distance 7,5 mm)

Grenzdaten (bezogen auf U_{BB}) max. ratings (related to U_{BB})		Betriebsbedingungen operating conditions		Informationsdaten characteristics	
U_{DD}	= −25 ... +0,3 V	U_{SS}	= 15,2 ... 16,8 V[1]	t_{RWC}	> 580 ns
U_{SS}	= −25 ... +0,3 V	$U_{BB} - U_{SS}$	= 3 ... 4 V	t_{RC}	> 480 ns
U_I	= −25 ... +0,3 V	ϑ_a	= 0 ... 70 °C	t_{REF}	< 2 ms
U_O	= −25 ... +0,3 V			R_L	= 0,1 ... 1 kΩ

[1]) bezogen auf U_{DD}

[1]) refer to U_{DD}